

原子层沉积镀膜设备

产品名称	原子层沉积镀膜设备
公司名称	北京维意真空技术应用有限责任公司
价格	230000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧桥路25号院
联系电话	010-67947887 15611171559

产品详情

一、设备概述: T-ALD原子层沉积系统是专门为科研和工业小型化量产用户而设计的多片沉积系统。该系统电气完全符合CE标准,广泛应用于微电子、纳米材料、光学薄膜、太阳能电池等领域。

二、产品优势:

先进的软件控制系统:系统集成工艺配方、参数设置、权限设定、互锁报警、状态监控等功能于一体。

三、技术指标:

基片尺寸 12英寸及以下尺寸 基片加热温度 室温~300 前驱体源路数
标准3路前驱体管路,可选配 前驱体管路温度 室温~200,控制精度 ± 0.1 源瓶加热温度
室温~200,控制精度 ± 0.1 ALD阀 Swagelok快速高温ALD专用阀
本底真空 $<5 \times 10^{-3}$ Torr,进口防腐泵 载气系统 N₂或者Ar 长模式 连续和停留沉积模式任意选择
控制系统 PLC+触摸屏或者显示器 电源 50-60Hz,220V/20A交流电源 沉积非均匀性
非均匀性 $< \pm 1\%$ 设备尺寸 600mm x 600mm x 1100mm

四、可沉积薄膜种类:

单质:Co, Cu, Ta, Ti, W, Ge, Pt, Ru, Ni, Fe... 氮化物:TiN, SiN, AlN, TaN, ZrN, HfN, WN
... 氧化物:TiO₂, HfO₂, SiO₂, ZnO, ZrO₂, Al₂O₃, La₂O₃, SnO₂... 其它化合物:GaAs, AlP, InP,
GaP, InAs, LaHf_xO_y, SrTiO₃, SrTaO₆...

五、ALD应用实例:

存储容性电介质,铜互连中高深宽比扩散阻挡层,OLED无针孔钝化层,MEMS的高均匀镀膜,
纳米多孔结构镀膜,特种光纤掺杂,太阳能电池,平板显示器,光学薄膜,其它各类特殊结构纳米薄膜

